



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

INSTITUTO DE CIENCIAS

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

**“Modulación de propiedades de silicio
poroso preparado por grabado químico
asistido por metal, mediante aplicación de
luz durante la síntesis”**

T E S I S

para obtener el grado de Maestro en Ciencias en Dispositivos
Semiconductores

Sustentante:

MIGUEL ANGEL JUÁREZ ESTRADA

Asesores:

Dra. Estela Gómez Barojas
Dr. Enrique Quiroga González

Enero 2019, Puebla, México



Benemérita

Nº 099749

Universidad Autónoma de Puebla

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Folio BUAP: 0130498

BUAP

ACTA DE EXAMEN DE GRADO

En la Ciudad de Puebla, Puebla siendo las 12:30 horas del día veintitres del mes de enero de dos mil diecinueve, reunido en

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Los integrantes del Honorable Jurado de Examen de Grado:

Presidente DR. JOSE ALBERTO LUNA LOPEZ

Secretario DR. JOSE ALVARO DAVID HERNANDEZ DE LA LUZ

Vocal DR. MAURICIO PACIO CASTILLO

Proceden a examinar a: JUAREZ ESTRADA MIGUEL ANGEL

Quienes al terminar el examen resolvieron: APROBARLO POR UNANIMIDAD

para obtener: EL GRADO DE MAESTRO EN DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Acto continuo el presidente del Jurado le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la protesta de Ley correspondiente.

Se expide la presente Acta de Examen en la ciudad de Puebla, Puebla a 29 de enero del 2019.

Con las facultades conferidas por la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Estatuto Orgánico de la misma

CERTIFICAN

La presente Acta de Examen de Grado

EL SECRETARIO GENERAL DE LA BUAP

LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

DR. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ

MTRA. MARÍA ELENA RUÍZ VELASCO



NOTAS IMPORTANTES AL REVERSO